⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-195957

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

砂発

リードフレーム

②特 顧 昭59-50939

❷出 顧 昭59(1984)3月19日

砂発明者 谷川

明 者

商太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

切出 顧 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

切代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

沢

#### 明 却 會

発明の名称 リードフレーム

### **特許請求の範囲**

1. 偶面に突出部を設けて成ることを特象とするリードフレーム。

2. 前記リードフレームがプラスチックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

## 発明の詳細な説明

## 〔技智分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの密着性を良くし、対止性のよい樹脂 対止型半導体装置を得ることができるリードフレームに関する。

# 〔智景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1日に 示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技御」P137~P150など)。第1日に て、1は半導体テップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

A CHARLES OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF THE

体チップの内部配銀をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電源及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法などに より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体接載を得ることができる。

ところで、かかる樹脂割止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性(耐湿性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チェブの大形化に伴ない、割止巾が増々狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装備に使用されるリードフレームにあっては、その側面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

#### 〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの告着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの告着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および既付図面からあき らかになるであろう。

#### [発明の氨要]

本版において関示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 飲付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面模増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの優気等の浸透性異物の侵入 の半導体チェブへの到達時間を長くして、対止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

#### [実施例]

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2回は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3回は第2回I-I線断面図を示す。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

問取封止型半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂対止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配数をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合会により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の固路業子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路業子は例えば、絶景ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば原理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(A8)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキシ樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5回は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の関係で横方向に複数の線系の標部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂對止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の樹脂対止体11に担込まれる長さが次第に短付なってきている。そうすると、リード14を折曲げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが樹脂対止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

#### 〔劝 录〕

- (1) リードフレームの切断面に良付けを行ない、 側面に奥出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られ る。
- (2) 告着函数の増大により、レジン量が増大し、

かつ、傷間がフラットである場合に比較して、段が形成されているのでリータペスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への浸透性異物の侵入が遅くなり対止性(耐湿性)が向上する。(3) リードフレームとレジンとの密着性、対止型半の自然性を著しく向上できるができる。(4) 半導体チップが大変化し、リードのモールドレジンはれている部分が増々短くい、リードフレームに設付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の向上の関リードフレームとレジンとの密着性の向上の関リードフレームとレジンとの密着性の向上の関リードフレームとレジンとの密着性の向上の関リードフレームとレジンとの密着性の向上の関リードフレームとレジンとの密着性の向上し、対止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得ることは工業上極めて有意である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 排部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるん だり、樹脂封止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上配実施例に限定されるものではなく、その要旨は造成しない範囲で置々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、首記実施例では、リードフレーム側面 全体化突出部を致けた例を示したが、一部に突出 部を致けても差支えない。又前配実施例では講部 をリード上面のみに致けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに致けてもよい。

## [利用分野]

本発明はデニアルインライン(DIL)タイプのパッケージの体、フラットパッタタイプのパッケージ など他の機能対止競半導体装置にも適用することができ、機能対止競半導体装置全紋に適用できる。 又電子部品のパッケージ技能にも適用できる。 回面の簡単な説明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2回は本発明リードフレームの要部例視図、 第3回は第2回Ⅰ-Ⅰ練斯面図、

第4四は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂對止型半導体装置の断軍圏、

第5回は本発明の他の実施例を示すリードフレ

ームの平面包である。

1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、

… 構設穴、B … 英出部、9 … 半導体チック、10 ladfanl mコネクタワイヤ、11 … 機関対止体、12 … y

ードフレーム、13…チブ、14…リード、1

…突出部、16…壽部。 へ

1. 21 x 27" . 1 . 1

代理人 弁理士 高 編 明 夫





